

تاثیر لایه های انتقال دهندهی حفره PTAA وPEDOT:PSS بر ریخت شناسی و

عملکرد در ساختار سلول خورشیدی پروسکایتی مسطح معکوس

زينب صفرى' | محمود برهاني زرندي'*|محمدرضا ناطقي ً

^۱گروه اتمی و مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد ^۲گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد

چکیده: در این پژوهش، از ساختار سلول خورشیدی پروسکایتی مسطح معکوس به دلیل داشتن ویژگیهای برجسته از جمله، ساخت در دمای پایین و هزینه ساخت پایین، استفاده شده است، اثر دو لایهی انتقال دهنده حفره PDOT:PSS و PTAA (بهعنوان لایهی زیرین پروسکایت) بر ریختشناسی لایه پروسکایت و پارامترهای موثر بر عملکرد سلول خورشیدی (Jsc, Voc, FF, PCE) بررسی شد. تصاویر SEM و AFM نشان داد، ریختشناسی مناسب و پوشانندگی بالای فیلم پروسکایت با لایهی PTAA در مقایسه با فیلم پروسکایت با لایهی PTAA نشان داد، ریختشناسی مناسب و پوشانندگی بالای فیلم پروسکایت با لایهی RTAA در مقایسه با فیلم پروسکایت با لایهی آنها به PTA۲، رسید، در حالی که بیشینهی بازدهی بر سلول خورشیدی مبتنی بر PDOT:PSS است.

واژگان کلیدی: سلول خورشیدی ، پروسکایت، لایه انتقال دهنده حفره، ساختار مسطح معکوس، ریختشناسی.

mborhani@yazd.ac.ir

۱ – مقدمه

نانومقياس

با پیدایش سلولهای خورشیدی پروسکایتی هالیدی آلی-معدنی، توجه پژوهشگران بر این دستگاههای فتوولتائیک جدید متمرکز شده است، زیرا آنها مزایای خاصی را به ارمغان میآورند، دارای ویژگیهای برجستهی از جمله وزن سبک، هزینه پایین، ساخت ساده و بازده تبدیل قدرت بالا (بیش از ۲۲٪) هستند [۱–۴]. با این حال، سلولهای خورشیدی پروسکایتی از معایبی، مانند ثبات و انعطاف پذیری پایین رنج میبرند، که مانع از کاربرد تجاری آنها شده است [۵, ۶]. تاکنون تغییراتی در معماری و روشهای ساخت برای بهبود عملکرد و پایداری این سلولها انجام شده است ساخت برای بهبود عملکرد و پایداری این سلولها انجام شده است یروسکایتی مطرح شده، ساختارهای که برای سلولهای خورشیدی پروسکایتی مطرح شده، ساختارهای متخلخل و مسطح است ایر ۱۰, ۱۰]. سلولهای خورشیدی پروسکایتی متخلخل/مسطح به دو

که این چیدمانها، بستگی به توالی لایهنشانی لایههای حامل های بار در اطراف پروسکایت دارد [۱۲ و ۱۳]. متداول ترین ماده-ی که به عنوان انتقال دهنده حفره و الکترون در سلول های خورشیدی پروسکایتی متخلخل مورد استفاده قرار می گیرد، به ترتیب OMETAD و TiO2 است [۹۲ و ۱۵]. لایهی ترتیب OMETAD و TiO2 است (۹۲ و ۱۵]. لایهی درجه سانتیگراد)، که تجاری سازی سلول خورشیدی را محدود می سازد (۱۴ و ۱۶]. مادهی Spiro-OMETAD باعث افزایش چشمگیر بازدهی سلول های خورشیدی پروسکایت شده است، اما مادهی Spiro-OMETAD بسیار گرانقیمت است و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست (۹۲ و ۱۸]. مسئلهی قابل توجه مادهی Spiro-OMETAD بسیار گرانقیمت است و از نظر مادهی Spiro-OMETAD بسیار گرانقیمت است و از نظر تحرک پذیری حفره نیاز به ترکیبات افزودنی همچون نمکی از در مورد Li-TFSI) و ترت بوتیل پیریدین به نسبت زیاد دارد متاسفانه، این ترکیبات اغلب تأثیر منفی بر ثبات دستگاه دارند

تاریخ دریافت : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ تاریخ پذیرش : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

الكترودهاى شفاف ITO با روشهاى چرخشى لايهنشانى [۱۹]. بنابراین، گرانقیمت بودن و پایداری محدود از نقاط ضعف می شود. ضخامت PDOT:PSS بر بسترهای ITO بسته به این ماده است [۱۸و ۱۹]. بنابراین، برای کاهش دما و قیمت گرانروی، میزان رسوب، بین ۱۰ تا ۲۰ نانومتر گزارش شده است r۸, PDOT:PSS. در حقیقت، به علت ویژگی اسیدی PDOT:PSS ، ضخيم بودن اين لايه باعث تخريب فيلم پروسكايت دز ساختارهای مستقیم می شود .افزون بر این، لایهی PDOT:PSS با ضخامت زیاد و بدون میدان الکتریکی درونی میتواند منجر به کاهش تحرکپذیری حاملهای بار می شود و عملکرد سلول را تخريب مي كند. بنابراين، ضخامت و پوشش مناسب لايه PDOT:PSS بسیار در عملکرد سلول تاثیرپذیر است [۲۹]. بطوریکه، ایجاد یک پوشش نامناسب PDOT:PSS بر سطح ITO سبب افزایش جریان نشتی در سلول خورشیدی پروسکایتی می شود و به شدت عملکرد دستگاه را تضعیف می کند. یکی دیگر از محبوب ترین لایه های انتقال دهنده ی حفره در ساختارهای مسطح معکوس PTAA است [۳۰]. از جمله ویژگیهای PTAAمى توان بە تحرك پذيرى بالاى الكترونها، شفافيت زياد، پایداری محیطی و نیاز نداشتن به دمای پخت بالا اشاره کرد [۳۰]. علاوه بر این، از آنجا که پارامترهای موادهای بسپاری مانند وزن مولکولی و انحلال پذیری به طور قابل توجهی بر تحرک حامل های بار و ریخت شناسی فیلم اثر می گذارد، ماده انتقال دهنده بسپاری PTAA مستثنی از این قضیه ناست [۳۱]. اخیراً در گزارشی تاثیر وزن مولکولی PTAA را بر عملکرد سلول خورشیدی بررسی کردهاند و بیشترین بازدهی (۱۶٬۴۶) را برای PTAA با وزن مولکولی بالا گزارش کردند [۳۲]. در یک گزارش دیگر، در مقایسه ی سلولهای خورشیدی پروسکایتی با لایه انتقال دهنده حفره PTAA و Spiro-OMeTAD، دستگاههای مبتنی برPTAA دارای مقدار تخریب بسیار پایین تر نسبت به دستگاه های مبتنی بر Spiro-OMeTAD را هستند [۳۳]. به عنوان مثال،Duong و همکارانش نشان دادند، سلولهای خورشیدی یروسکایتی با لایه انتقال دهنده PTAA یایداری گرمایی بهتری در دمای ۸۵ درجه سانتی گراد دارند [۳۴]. در این پژوهش، از دو انتقال دهنده حفره ی PTAA و

PDOT:PSS در ساختار سلول خورشیدی پروسکایتی مسطح معکوس استفاده کردیم و به مقایسهی طیف جذب در گسترهی طول موج (۸۵۰–۴۰۰ نانومتر)، ریختشناسی و توزیع نانوذرات

پاییز ۱۳۹۸ | شماره سوم | سال ششم

توليد، سلولهای خورشيدی پروسکايتی مسطح معکوس و مستقیم به سرعت در حال توسعه هستند [۱۱و ۱۲]. پژوهشگران به تازگی ساختارهای مسطح معکوس را ارجحتر میدانند، چون این ساختارها بهطور معمول هیسترزیس ناچیزی را نشان میدهند [۱۲]، برخلاف سلولهای خورشیدی پروسکایتی مسطح مستقیم كه منحنى ولتاژ-جريان از هيسترزيس بالا رنج مىبرد. بنابراين، سلول های خورشیدی پروسکایتی مسطح معکوس پتانسیل زیادی در دستیابی به سلولهای با قابلیت اطمینان بالا دارند [۲۰]. برای غلبه بر چالش دما و قیمت، مواد انتقال دهندهی حفره که به طور گسترده در ساختارهای مسطح معکوس استفاده می شوند، عبارتند از: پلی استایرن سولفونات PDOT:PSS، پلی تری آریل آمین PTAA، نیکل اکسید NiO، مس تیوسانت CuSCN و مسیدید CuI است [۲۱-۲۵]. لازم به ذکر است، لایههای انتقال دهنده حفره نقش مهمی در ساختار سلول خورشیدی پروسکایتی دارند. آنها انتقال، حفره را بهبود می بخشند و تاثیر زیادی بر روی ولتاژ مدار باز (Voc) دارند. در واقع، انتخاب یک لایه انتقال دهنده حفره مناسب منجر به بالا رفتن Voc تا گسترهی ۱/۵ تا ۱/۶۱ ولت در سلول خورشیدی پروسکایت می شود [۲۲ و ۲۶]. همچنین، لایه انتقال دهندهی حفره به عنوان لایهی زیرین فیلم پروسکایت در موارد بسیاری باعث بهبود کیفیت سطح لایه پروسکایت شده، در مقایسه با حالتی که از حضور آنها در ساختار سلول خورشیدی مسطح معکوس صرف نظر شده باشد [۲۶]. همچنین، با توجه به توالی لایهنشانی این لایهها از تماس مستقيم پروسكايت با الكترودها ساختار سلول خورشيدي جلوگیری کرده در نتیجه از بازترکیب حاملهای بار جلوگیری می کند و منجر به بهبود عملکرد دستگاه می شوند [۲۷]، از دیگر مزایای استفاده از آن، سبب بهبود عملکرد سلول خورشیدی می شود. PDOT: PSS از محبوب ترین مواد انتقال دهنده ی حفره در ساختارهای مسطح معکوس است. از ویژگیهای برجسته این انتقال دهنده حفره می توان به قابلیت پوشش دهی خوب، پایداری حرارتی بالا، انعطاف پذیری مکانیکی خوب، شفافیت مطلق نوری، دمای پخت پایین و همچنین سطح مناسب انرژی اشاره کرد [۱۲و ۲۱]. بهطور معمول PDOT:PSS بر

پروسکایت رشد داده شده بر سطح بر دو انتقال دهنده ی حفره pTAA و PDOT:PSS پرداختیم. در ادامه، عملکرد سلولهای خورشیدی ساخته شده مبتنی بر این دو لایه انتقال دهنده حفره را بررسی کردیم.

۲- بخش تجربی

۲-۱- مواد و تجهیزات مورد استفاده

حلالهای استون، اتانول (۹۸٪)، تولوئن (۹۸٪)، ان ان دی اتیل فرم امید (DMS) و دیمتیل سولفواکسید (DMSO) از شرکت مرک، سرب یدید (PbI2) ۹۹٪، متیل آمونیم یدید (MAI) ۹۸٪، پلی تری آریل آمین(PTAA) و پلی استایرن سولفونات (PDOT:PSS) از شرکت سیگما آلدریچ، PCBM و BCP از شرکت Sila تهیه گردیده است.

برای مطالعه و بررسی سطح پوشش و ریخت شناسی پروسکایت ایجاد شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی Carl ایجاد شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی Carl پروسکایت از میکروسکوپ نیروی اتمی مدل Model DEM (model DEM استفاده شده است. برای بررسی عملکرد فتوولتائیکی و مشخصهیابیهای ولتاژ –جریان برای تعیین بازده فتوولتائیکی و مشخصهیابیهای ولتاژ –جریان برای تعیین بازده سلول، اندازه گیری جریان مدار کوتاه و ولتاژ مدار باز از دستگاه شبیه ساز سلول خورشیدی Aurico و ولتاژ مدار باز از دستگاه شبیه ساز سلول خورشیدی Aurico و محادل PTAA استفاده شد. طیفهای جذب فیلم پروسکایت پوشش داده شده بر PTAA و UV-Vis با ستفاده از اسپکتوفومتر SPECORD 250)

۲-۲- روش ساخت

به منظور ساخت سلول، از ITO به عنوان زیرلایه استفاده شد. سلولهای خورشیدی لایه نازک و نانو ساختار، نسبت به آلودگی های سطحی زیرلایه، بسیار حساس هستند. به همین منظور زیرلایهها در چندین مرحله شستشو داده و درون یک بشر قرار های ITO با آب و صابون شستشو داده و درون یک بشر قرار داده می شوند و با محلول آب دو بار تقطیر، استون و اتانول به

مدت ۱۵دقیقه به ترتیب هر کدام در حمام فراصوت شستشو داده می شوند. سپس زیر لایه ها با جریان گاز N₂ خشک شده تا مرحله شستشو به اتمام برسد. در ادامه برای لایهنشانی، لایه انتقال دهندهی حفره، ابتدا مقدار ۲/۵ میلی گرم از PTAA و در ۱ ميلى ليتر تولوئن حل كرده، سپس، محلول PTAA و PDOT:PSS را با استفاده از دستگاه لایهنشانی چرخشی با دو سرعت ۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ دور بر دقیقه و به مدت ۶۰ ثانیه بر بسترهای ITO لایه نشانی شده و هر دو فیلم به ترتیب در دمای ۱۱۰ و ۱۵۰ درجه سانتیگراد خشک می شوند. در مرحله بعدی، به منظور تشکیل فیلم پروسکایت به روش تک مرحلهی بر روی لايههاى PTAA و PDOT:PSS، محلول يروسكايت كه متشکل از ۴۶۱ میلی گرم سرب یدید، ۱۵۹ میلی گرم پودر مای، ۶۳۵ میکرولیتر DMF و ۷۱ میکرولیتر DMSO به روش لایهنشانی چرخشی بر روی زیرلایههای انتقال دهندهی حفره لايهنشاني مي شوند. سپس، دو لايه انتقال دهندهي الكترون و سد کننده حفره PCMB و BCP به ترتیب با سرعت ۶۰۰۰ و ۹۰۰۰ دور بر دقیقه لایهنشانی شدند. در نهایت لایه نازک آلومنیم با ضخامت ۵۰ نانومتر با روش تبخیر در خلاً بر روی لایه BCP قرار گرفت.

۳- نتایج و بحث

شکل (۱) ساختار طرحواره سلول خورشیدی پروسکایت مسطح معکوس و شکل (۲) ساختار مولکولهای PTAA، PCBM ، PDOT:PSS و BCP را نشان میدهند. ماده PCBM علاوه بر انتقال دهنده ی الکترون مناسب، سبب افزایش عملکرد و کاهش هیسترزیس در سلول خورشیدی پروسکایتی می شود [۳۵, ۳۶]. ماده BCP به عنوان سد کننده ی حفره کاربرد دارد، علاوه بر اینکه سبب بهبود انتقال الکترون می شود مانند سدی از عبور حفره جلوگیری می کند [۳۷].



شکل (۱): ساختار سلول خورشیدی پروسکایت مسطح معکوس



شكل (٢): ساختار مولكولى PDOT:PSS ،PCBM ،BCP وPTAA

مادههای PDOT:PSS و PTAA لایههای انتقال دهنده ی حفره هستند و همانطور که از طرحواره شکل (۱) مشخص است بهعنوان زیر لایه ی برای فیلم پروسکایت محسوب می شوند، بنابراین، داشتن پوشش مناسب از این مادهها سبب بالا رفتن کیفیت فیلم پروسکایت خواهد شد. یکی دیگر از پارامترهای بسیار تاثیرگذار بر عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایت بلورینگی و ریخت شناسی نانوذرات، لایه پروسکایت است [۳۸]. شکل (۳) تصاویر SEM مربوط به ریخت شناسی نانوذرات در لایه پروسکایت رشد داده شده بر بسترهای PEDOT: PSS و PTAA را نشان می دهد. نانو بلورهای پروسکایت مبتنی بر ATA را نشان می دهد. نانو بلورهای پروسکایت مبتنی لایه ی پروسکایت باعث جذب بیشتر نور و کارایی سلول خورشیدی می شود. در حالیکه حفرههای ریزی در سطح فیلم پروسکایت پوشش داده شده بر سطح PSS PEDOT: PSS

(شکل ۳–الف) به وضوح مشخص است (دایرههای قرمز رنگ در شکل (۳–الف) تعداد معدودی از حفرهها را نشان میدهد). این پوشش فیلمهای پروسکایت نمیتواند برای یک دستگاه سلول خورشیدی با کارآیی بالا مناسب باشد.



شکل (۳): تصاویر SEM از سلولهای پروسکایتی ساخته شده، بر لایههای انتقال دهندهی حفره PEDOT: PSS (الف) و PTAA (ب)

افزون بر این، سایز دانههای پروسکایت ابعاد کوچکتری در حالتی که PEDOT: PSS لایهی انتقال دهنده حفره است، دارد. سایز کوچک بلورهای پروسکایت باعث افزایش تعداد مرزدانه ها شده و عامل مخربی در عملکرد دستگاه محسوب میشود. بهخوبی شناخته شده است که حضور حفرههای ریز و افزایش تعداد مرزدانهها در فیلم پروسکایت، سبب افزایش بازترکیب الکترونها و حفرهها میشود و در نهایت ثبات و عملکرد دستگاه را محدود می سازد [۴].

در شکل (۴)، تصویر AFM از سطح فیلم پروسکایت لایه نشانی شده بر مادههای انتقال دهنده حفره PDOT:PSS مشاهده می شود.



شکل (۴): تصاویر AFM از سلولهای پروسکایتی ساخته شده، بر لایههای انتقال دهنده حفره PEDOT: PSS (الف) و PTAA (ب)

لکههای تیره (سیاه رنگ) در تصویر AFM فیلم پروسکایت لایه نشانی شده بر سطح PDOT:PSS (شکل ۴–ب) نشان دهنده تخریب زنجیرهی PSS در فیلم PDOT:PSS است. به نظر میرسد، حلال DMSO موجود در محلول پروسکایت در فرایند لایهنشانی و آمادهسازی فیلم پروسکایت سبب تخریب فیلم PEDOT: PSS شده است. ممکن است، سبب کاهش ولتاژ مدار باز شود و کارایی سلول خورشیدی را تخریب کند.

نمودار طیف جذب برای هر دو سلول ساخته شده با انتقال دهندههای حفره PEDOT: PSS و PTAA در شکل (۵)

مشاهده می شود. حضور حفرهها و سایز بسیار ریز نانوذرات فیلم پروسکایت مبتنی بر PEDOT: PSS که باعث افزایش تعداد مرزدانهها شد، همچنین، سبب باعث کاهش جذب در این فیلم پروسکایت نسبت به پروسکایت مبتنی بر PTAA می شود (نمودار جذب شکل(۵)). در نمودار طیف جذب برای هر دو حالت، یک پیک بهنسبت ضعیف در گستره طول موج ۴۵۰ نانومتر مشاهده می شود که حضور مقدار کمی از PbI2 در فیلم پروسکایت را تایید می کند که برای دستیابی به ولتاژ مدار –باز بالاتر مفید است.



شکل (۵): نمودار طیف جذب از سلولهای پروسکایتی ساخته شده، بر لایههای انتقال دهنده حفره PTDOT: PSS و PTAA

تصاویر سطح مقطع سلول خورشیدی پروسکایت با انتقال دهندههای حفره PTAA و PEDOT:PSS در شکل (۶) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، ضخامت کل فیلمهای PTAA/Perovskite/PCBM/BCP در سلول خورشیدی پروسکایت تقریبا ۶۲۴ نانومتر و ضخامت کل فیلمهای خورشیدی پروسکایت تقریبا ۶۶۶ نانومتر است. با توجه به بورشیدی پروسکایتی فوق تقریباً ۶۶۵ نانومتر است. با توجه به اینکه شرایط یکسانی در هر دو نوع سلول خورشیدی برای نظر گرفته شده است، انتظار می ود ضخامت لایه پروسکایت و نظر گرفته شده است، انتظار می ود ضخامت لایه پروسکایت و بنابراین، این اختلاف در ضخامت ساختارها، به دلیل ضخامت متفاوت لایههای PTAA و PEDOT:PSS است. شواهد

حاکی آن است که ضخامت لایه PTAA کمتر از لایه PEDOT:PSS است.



شکل (۶): تصاویر SEM از سطح مقطع سلول خورشیدی پروسکایت با لایههای انتقال دهنده حفره PEDOT (الف) و PEDOT:PSS (ب)

بررسی اثر لایههای انتقال دهنده حفره PEDOT: PSS و PTAA بر عملکرد سلول خورشیدی و پارامترهای فتوولتائیکی (Jsc : چگالی جریان مدار کوتاه، Voc: ولتاژ مدار باز، FF: عامل پرشدگی و PCE: بازده تبدیل توان) با استفاده از دستگاه Keithley 2400 و شبیهساز خورشیدی با AM 1.5G استخراج شد. لازم به ذکر است که بازده تبدیل توان سلول خورشیدی به سه پارامتر فوتولتائیکی (Jsc, Voc, FF) وابسته است. معادلات (۱) و (۲) وابستگی بازده تبدیل توان سلول را به این پارامترهای فوتولتائیکی را نشان میدهد .

در این روابط، V_{max} و J_{max} به ترتیب ولتاژ و چگالی جریان ماکزییم، Pin توان نور هستند.

$$FF = \frac{V_{max} \times J_{max}}{V_{oc} \times J_{sc}} \tag{(1)}$$

$$PCE = \frac{V_{OC} \times J_{sc} \times FF}{P_{in}}$$
(7)

نتایج پارامترهای فتوولتائیکی و اندازه آنها ، در جدول (۱) آورده شده است.

| جدول (۱) پارامترهای فتوولتائیکی | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| انتقال دهنده حفره | Jsc (mA/cm ²) | FF (%) | Voc (V) | PCE (%) |
| РТАА | ۱۵/۲۵ | ۶۹/۸ | ١/•٧ | ۱۱/۳۷ |
| PEDOT: PSS | ١٣/٩٧ | 84/2 | ۱/۰۳ | ٩/٢٣ |

همان طور که از نتایج جدول مشهود است، بازدهی در سلول خورشیدی پروسکایتی ساخته شده مبتنی PTAA به ۱۱/۳۷٪ است در حالی که، بازدهی در سلول خورشیدی پروسکایتی با لایه PEDOT: PSS، است. این افزایش بازدهی به دلیل اینست که چگالی جریان و فاکتور پرشوندگی در این سلول نسبت به سلول مبتنی بر PEDOT: PSS بیشتر است. علت بهبود FF به ريخت شناسي نانوذرات و كيفيت لايهها بخصوص لايه پروسکایت برمی گردد. در واقع، لایه PTAA سبب بهبود کیفیت لايه پروسكايت و ايجاد پوشش فشردهتر پروسكايت مى شود، مقدار حفره در این فیلم پروسکایت کمتر است، که این عوامل باعث بهبود FF مى شود. از طرفى كيفيت بالاى لايه پروسكايت دلیل دیگری برای انتقال بیشتر الکترون-حفره و بهبود تحرک حامل های بار است، که سبب بهبودی J_{sc} می شود. از عامل موثر بر افزایش V_{oc} در سلولهای خورشیدی پروسکایت انتخاب مادههای انتفال دهنده حفره با گاف باند انرژی مناسب است. بهبود $V_{\rm oc}$ در سلول خورشیدی با لایه انتقال حفره PTAA به $V_{\rm oc}$ دلیل گاف باند انرژی بهنسبت بزرگ این ماده است. در شکل (۷) و (۸) به ترتیب، نمودار مربوط به چگالی جریان – ولتاژ سلولها با انتقال دهندهی PTAA وPEDOT: PSS و شماتیک ساختار گاف نواری سلول خورشیدی نشان داده شده است.

کوچکتر هستند، بنابراین، تعداد مرزدانه ها در فیلم پروسکایت مبتنی بر PEDOT: PSS بیشتر است و همچنین ریخت شناسی فیلم پروسکایت مبتنی بر PTAA با کیفیت ر و فشرده تر است در حالیکه حفرههای ریزی در ریخت شناسی پروسکایت پوشش داده شده بر PEDOT: PSS وجود دارد. زیرا حلال DMSO موجود در محلول پروسکایت در فرایند لایه نشانی و آماده سازی فیلم پروسکایت سبب تخریب فیلم PEDOT: PSS شده است. بنابراین باعث ایجاد حفرهها در لایهی پروسکایت شده است. بنابراین ریخت شناسی نامناسب لایه پروسکایت مبتنی بر PEDOT: PSS مسلول خورشیدی می شود. در نتیجه، لایهی PTAA در کنترل ریخت شناسی لایه پروسکایت بسیار موثر بوده است، بنابراین مسلول خورشیدی می شود. در نتیجه، لایهی PTAA در کنترل مسلول خورشیدی می شود. در نتیجه، لایه که بیشنه بازدهی بر سلول خورشیدی مبتنی بر PEDOT PSS (PST) مربر است.

مراجع

- [1] Anaraki, E.H., et al., "Highly efficient and stable planar perovskite solar cells by solution-processed tin oxide," Energy & Environmental Science, 9, 3128-3134, 2016.
- [2] Zuo, C., et al., "Advances in perovskite solar cells," Advanced Science, 3, 1500324, 2016.
- [3] Correa-Baena, J.-P., et al., "The rapid evolution of highly efficient perovskite solar cells," Energy & Environmental Science, 10, 710-727, 2017.
- [4] Safari, Z., M.B. Zarandi, and M.R. Nateghi, "Improved environmental stability of HTM free perovskite solar cells by a modified deposition route," Chemical Papers, 1-12, 2019.
- [5] Troughton, J., et al., "Highly efficient, flexible, indium-free perovskite solar cells employing metallic substrates," Journal of Materials Chemistry A, 3, 9141-9145, 2015.
- [6] Jeon, I., et al., Carbon nanotubes versus graphene as flexible transparent electrodes in inverted perovskite solar cells," The



شکل (۷): نمودار چگالی جریان – ولتاژ برای سلول خورشیدی پروسکایتی با لایههای انتقال دهندهی حفره PTAA وPEDOT:PSS



شکل (۸) : طرحواره ساختار گاف نواری ولتاژ برای سلول خورشیدی پروسکایت

۴- نتیجه گیری

در این پژوهش، با استفاده از لایههای انتقال دهنده حفره، در ساختار سلول خورشیدی پروسکایتی مسطح معکوس، اثر دو لایهی PTAA و PEDOT: PSS به عنوان لایه زیرین فیلم پروسکایت بر ریخت شناسی نانوذرات، بلورینگی لایه پروسکایت و پارامترهای فتوولتائیکی موثر بر بازده سلول خورشیدی ساخته شده به روش تک مرحلهی بررسی شد. سایز نانو ذرات پروسکایت تشکیل شده بر سطح PEDOT: PSS نسبت PTAA به

Hole - Conductor - Free Fully Printable Mesoscopic Perovskite Solar Cells," Advanced Materials, 29, 1606608, 2017.

- [18] Hua, Y., et al., Facile synthesis of fluorenebased hole transport materials for highly efficient perovskite solar cells and solidstate dye-sensitized solar cells," Nano Energy, 26,108-113, 2013.
- [19] Yang, L., et al., "Initial light soaking treatment enables hole transport material to outperform spiro-OMeTAD in solid-state dye-sensitized solar cells," Journal of the American Chemical Society, 135, 7378-7385, 2013.
- [20] Meng, L., et al., "Recent advances in the inverted planar structure of perovskite solar cells," Accounts of chemical research, 49, 155-165, 2015.
- [21] Wu, C.-G., et al., "High efficiency stable inverted perovskite solar cells without current hysteresis," Energy & Environmental Science, 8, 2725-2733, 2015.
- [22] Fu, F., et al., "High-efficiency inverted semi-transparent planar perovskite solar cells in substrate configuration," Nat. Energy, 2, 16190, 2016.
- [23] Hu, L., et al., "Sequential deposition of CH3NH3PbI3 on planar NiO film for efficient planar perovskite solar cells," Acs Photonics, 1, 547-553, 2014.
- [24] Ye, S., et al., CuSCN-based inverted planar perovskite solar cell with an average PCE of 15.6%," Nano letters, 15, 3723-3728, 2015.
- [28] Yan, W., et al., "Hole Transporting Materials in Inverted Planar Perovskite Solar Cells," Advanced Energy Materials, 6, 1600474, 2016.
- [28] Bakr, Z.H., et al., "Advances in hole transport materials engineering for stable and efficient perovskite solar cells," Nano Energy, 34, 271-305, 2017.
- [27] Liu, Y., et al., "A dopant-free organic hole transport material for efficient planar heterojunction perovskite solar cells," Journal of Materials Chemistry A, 3, 11940-11947, 2015.

journal of physical chemistry letters, 8, 5395-5401, 2017.

- [7] Wu, M.-C., et al., "Enhanced Photovoltaic Performance of Perovskite Solar Cells by Tuning Alkaline Earth Metal-Doped Perovskite-Structured Absorber and Metal-Doped TiO2 Hole Blocking Layer," ACS Applied Energy Materials, 1, 4849-4859, 2018.
- [8] Susrutha, B., L. Giribabu, and S.P. Singh, "Recent advances in flexible perovskite solar cells," Chemical communications, 51, 14696-14707, 2015.
- [9] Yang, Y., "Device architecture and characterization of organic and hybrid perovskite photovoltaic. 2015, UCLA.
- [10]. Lee, M.M., et al., "Efficient hybrid solar cells based on meso-superstructured organometal halide perovskites," Science, 338, p. 643-647, 2012.
- [11] Liu, M., M.B. Johnston, and H.J. Snaith, "Efficient planar heterojunction perovskite solar cells by vapour deposition," Nature, 501, 395, 2013.
- [12] Heo, J.H., et al., "Hysteresis-less inverted CH 3 NH 3 PbI 3 planar perovskite hybrid solar cells with 18.1% power conversion efficiency," Energy & Environmental Science, 8, 1602-1608, 2015.
- [13] Chatterjee, S. and A.J. Pal, "Introducing Cu2O thin films as a hole-transport layer in efficient planar perovskite solar cell structures," The Journal of Physical Chemistry C, 120, 1428-1437, 2016.
- [14] Zhou, H., et al., "Interface engineering of highly efficient perovskite solar cells," Science, 345, 542-546, 2014.
- [15] Kim, H.-S. and N-G. Park, "Parameters affecting I–V hysteresis of CH3NH3PbI3 perovskite solar cells: effects of perovskite crystal size and mesoporous TiO2 layer," The journal of physical chemistry letters, 5, 2927-2934, 2014.
- [16] Yamada, Y., et al., "Near-band-edge optical responses of solution-processed organic– inorganic hybrid perovskite CH3NH3PbI3 on mesoporous TiO2 electrodes," Applied Physics Express, 7,032302, 2014.
- [17] Zhang, H., et al., "SrCl2 Derived Perovskite Facilitating a High Efficiency of 16% in

نانومقىاس

- [38] Zadeh, N.J., M.B. Zarandi, and M.R. Nateghi, "Effect of crystallization strategies on CH3NH3PbI3 perovskite layer deposited by spin coating method: Dependence of photovoltaic performance on morphology evolution," Thin Solid Films 660, 65-74, 2018.
- [28] Malinkiewicz, O., et al., "Perovskite solar cells employing organic charge-transport layers," Nature Photonics, 8, 128, 2014.
- [29] Hu, L., et al., "PEDOT: PSS monolayers to enhance the hole extraction and stability of perovskite solar cells," Journal of Materials Chemistry A, 6, 16583-1658, 2018.
- [30] Saliba, M., et al., "How to Make over 20% Efficient Perovskite Solar Cells in Regular (n–i–p) and Inverted (p–i–n) Architectures," Chemistry of Materials, 30, 4193-4201, 2018.
- [31] Nia, N.Y., et al., "High efficiency perovskite solar cell based on poly (3 hexylthiophene): influence of molecular weight and mesoscopic scaffold layer," ChemSusChem, 10, 3854-3860, 2017.
- [32] Ko, Y., et al., "Investigation of holetransporting poly (triarylamine) on aggregation and charge transport for hysteresisless scalable planar perovskite solar cells," ACS applied materials & interfaces, 10, 11633-11641, 2018.
- [33] Vivo, P., J. Salunke, and A. Priimagi, "Hole-transporting materials for printable perovskite solar cells," Materials, 10, 1087, 2017.
- Duong, T., et al. "Impact of Light on the [34] Thermal Stability of Perovskite Solar Cells and Development of Stable Semitransparent Cells," in 2018 IEEE 7th World Conference Photovoltaic on Energy Conversion (WCPEC)(A Joint Conference of 45th IEEE PVSC, 28th PVSEC & 34th EU PVSEC), 2018.
- [35] Zhao, C., et al., "Revealing underlying processes involved in light soaking effects and hysteresis phenomena in perovskite solar cells," Advanced Energy Materials, 5, 1500279, 2015.
- [36] Xiong, J., et al., "Efficient and nonhysteresis CH3NH3PbI3/PCBM planar heterojunction solar cells," Organic Electronics, 24, 106-112, 2015.
- [37] Wang, Q., et al., "Large fill-factor bilayer iodine perovskite solar cells fabricated by a low-temperature solution-process," Energy & Environmental Science, 7, 2359-2365, 2014.

Effect of Hole transport layer PTAA and PEDOT:PSS on the Morphology and Efficiency in Inverted Planer Perovskiet Cell Solar Architecture

Z. Safari¹, M. Borhani Zarandi^{*1}, M. Nateghi²

¹Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd

²Department of Chemistry, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd

Abstract: In this study, the structure of the inverted planer solar cell was used because of its prominent features, such as low temperature construction and low cost construction, the effect of two layers of PDOT:PSS and PTAA (as the underlying perovskite) on the morphology perovskite layer and parameters affecting solar cell performance (Jsc, Voc, FF, PCE) were investigated.

SEM and AFM images showed that Proper morphology and high coverage of perovskite film with PTAA compared to perovskite film with PEDOT: PSS resulted in increased light absorption and efficiency in perovskite solar cell with PTAA. Their yields reached 11.37%, while the maximum PDOT: PSS-based solar cell efficiency was 9.23%.

Keywords: Solar cell, Perovskite, Hole transport layer, Inverted Planer structure, performance